

Выходной пентод

Output pentode

Выходной пентод 6П14П предназначен для усиления мощности низкой частоты.

Выходные пентоды 6П14П выпускаются в миниатюрном оформлении, в стеклянном баллоне с девяностырьковой ножкой, с оксидным катодом косвенного накала.

Выходные пентоды 6П14П устойчивы к воздействию окружающей температуры от -60 до $+70^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 95—98% при температуре $+40^{\circ}\text{C}$, а также механических нагрузок: вибрационных до 2,5 g, ударных много-кратных до 35 g.

Наибольший вес 20 г.

Гарантиированная долговечность 3000 часов.

The 6П14П output pentode is designed for amplification of low-frequency power.

The 6П14П output pentodes are miniature devices enclosed in glass bulb and provided with a nine-pin base and an indirectly heated oxide-coated cathode.

The 6П14П output pentodes are resistant to ambient temperature from -60 to $+70^{\circ}\text{C}$ and relative humidity of 95 to 98% at $+40^{\circ}\text{C}$, as well as to mechanical loads: vibration loads up to 2.5 g and multiple impact loads up to 35 g.

Maximum weight: 20 gr.

Service life guarantee: 3000 hr.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

U_h	6,3 V	R_k ¹⁾	120 Ω	I_{g2} ²⁾ ³⁾	$\leqslant 11$ mA
I_h	760 ± 60 mA	I_a	48 ± 8 mA	k_f ⁴⁾	$8^{+2}\%$
E_a	250 V	I_{g2}	5^{+2} mA	S	$11,3_{-2,3}$ mA/V
U_{g2}	250 V	P_k ²⁾	$4,2_{-1,2}$ W	R_i	30 k Ω

¹⁾ Для автоматического смещения.
For self-bias.

²⁾ При $U_{g1\sim eff} = 3,4$ V, $R_a = 5,2$ k Ω .
At $U_{g1\sim eff} = 3.4$ V, $R_a = 5.2$ k Ω .

³⁾ В динамическом режиме.
Under dynamic conditions.

⁴⁾ При $P_k = 4$ W.
At $P_k = 4$ W.

МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫЕ ЕМКОСТИ INTERELECTRODE CAPACITANCES

C_{g1k}	11 pF
C_{ak}	7 pF
C_{g1a}	0,2 pF

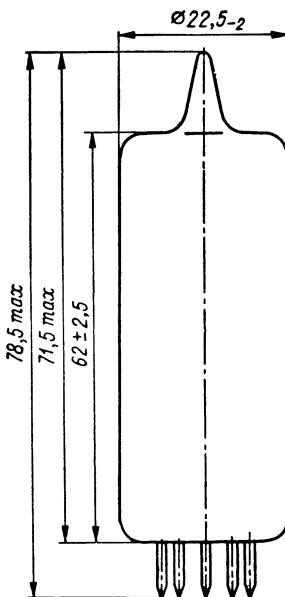
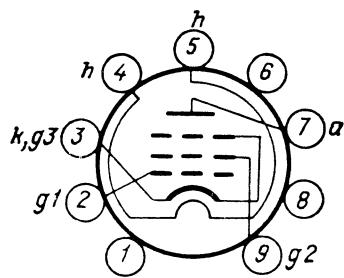
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS

	Max	Min		Max
U_h	7 V	5,7 V	I_k ³⁾	65 mA
U_a ¹⁾	400 V		U_{kh}	100 V
U_a ²⁾	300 V		R_{g1} ⁴⁾	1 MΩ
U_{g2}	300 V		R_{g1} ⁵⁾	0,3 MΩ
P_a	14 W		$T_{баллона}$	220° C
P_{g2}	2,2 W		bulb	

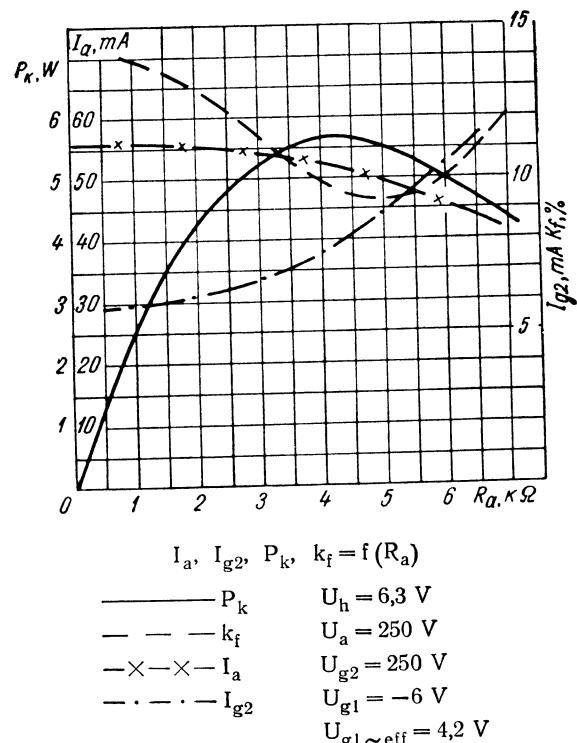
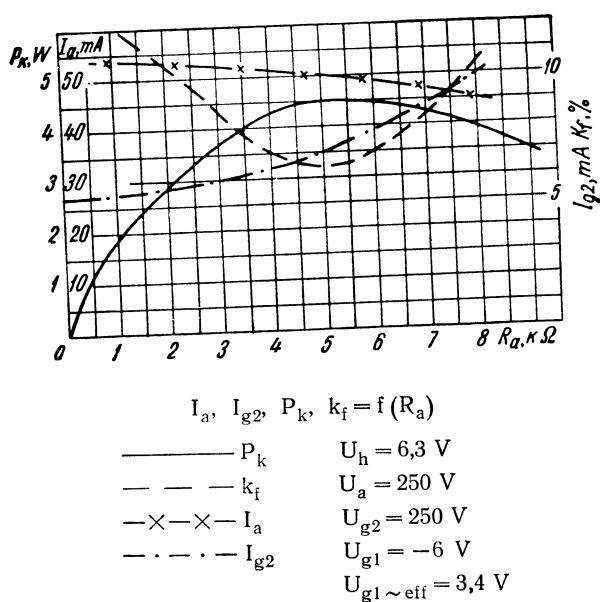
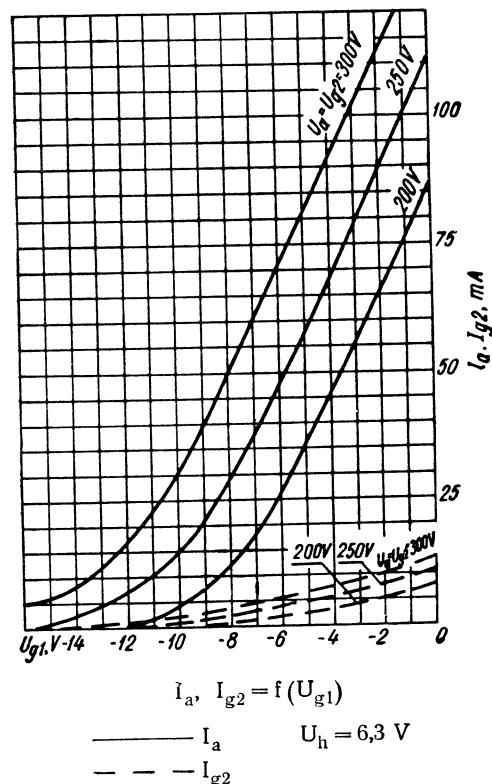
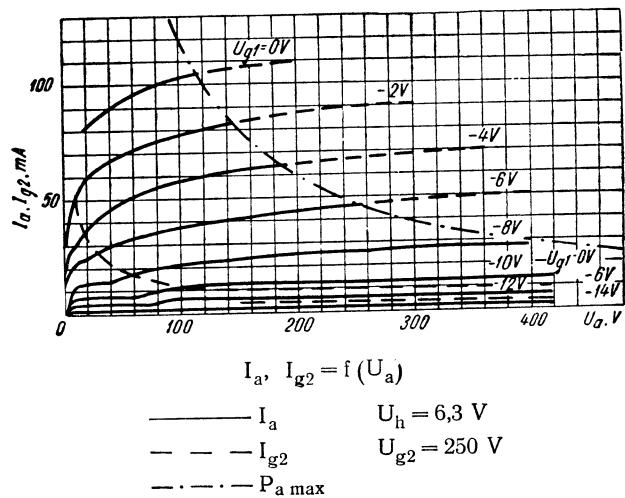
¹⁾ При $P_a \leq 8$ W.
At $P_a \leq 8$ W.²⁾ При $P_a \geq 8$ W.
At $P_a \geq 8$ W.³⁾ Среднее значение.
Average value.⁴⁾ При автоматическом смещении.
For self-bias.⁵⁾ При фиксированном смещении.
For fixed bias.

Допускается увеличение сопротивления в цепи первой сетки до 1 MΩ при фиксированном смещении и мощности, рассеиваемой на аноде и второй сетке, не более 75% от номинального значения.

The resistance in the first grid circuit may be increased to 1 MΩ with fixed bias and power dissipation on the anode and the second grid no more than 75% of the rated value.

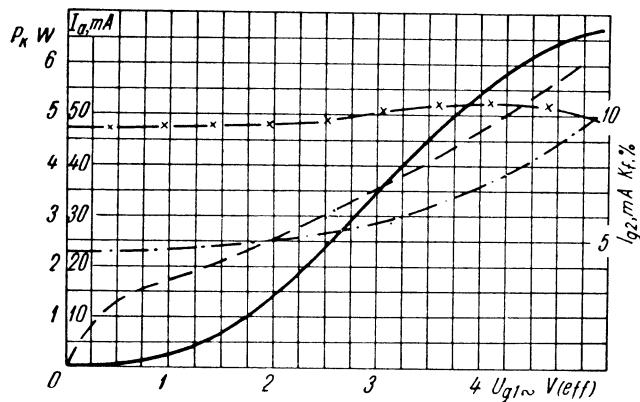


Выходной пентод
Output pentode



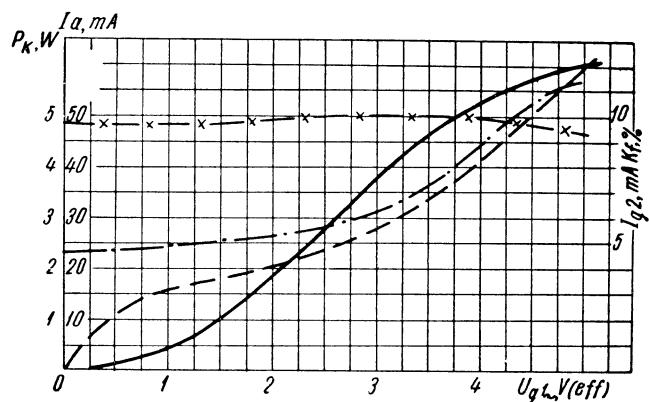
6П14П

Выходной пентод
Output pentode



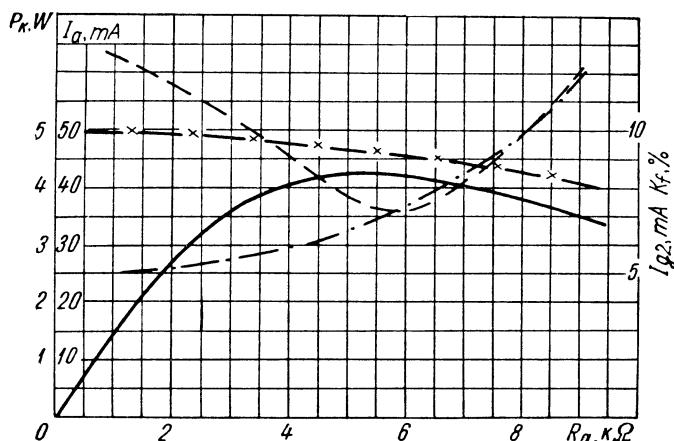
$$I_a, I_{g2}, P_k, k_f = f(U_{g1 \sim eff})$$

- | | |
|----------------|---------------------------|
| — — — P_k | $U_h = 6,3 \text{ V}$ |
| — — — k_f | $U_a = 250 \text{ V}$ |
| -×-×- I_a | $U_{g2} = 250 \text{ V}$ |
| -·-·- I_{g2} | $U_{g1} = -6 \text{ V}$ |
| | $R_a = 4 \text{ k}\Omega$ |



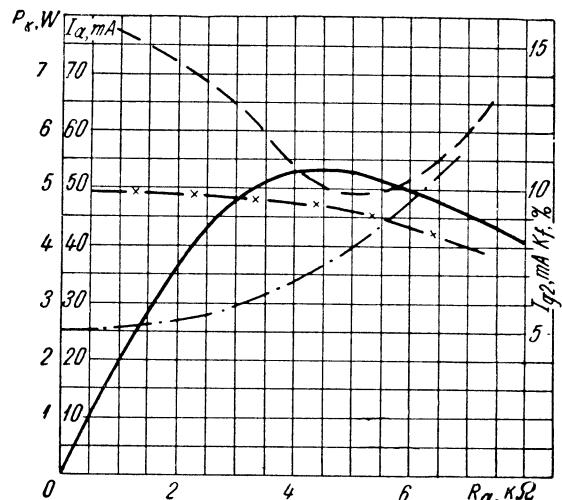
$$I_a, I_{g2}, P_k, k_f = f(U_{g1 \sim eff})$$

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| — — — P_k | $U_h = 6,3 \text{ V}$ |
| — — — k_f | $U_a = 250 \text{ V}$ |
| -·-·- I_{g2} | $U_{g2} = 250 \text{ V}$ |
| -×-×- I_a | $U_{g1} = -6 \text{ V}$ |
| | $R_a = 5,2 \text{ k}\Omega$ |



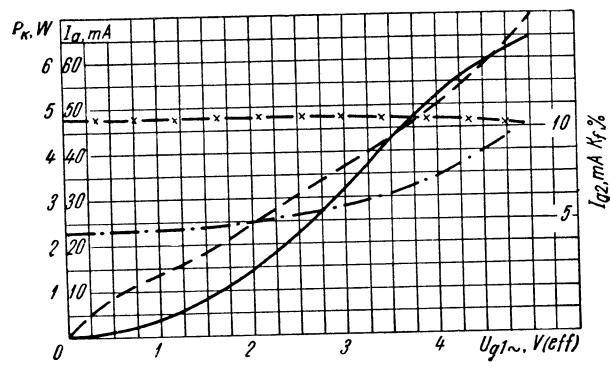
$$I_a, I_{g2}, P_k, k_f = f(R_a)$$

- | | |
|----------------|--|
| — — — P_k | $U_h = 6,3 \text{ V}$ |
| — — — k_f | $U_a = U_{g2} = 250 \text{ V}$ |
| -×-×- I_a | $U_{g1 \sim eff} = 3,4 \text{ V}$ r. m. s. |
| -·-·- I_{g2} | $R_k = 120 \Omega$ |

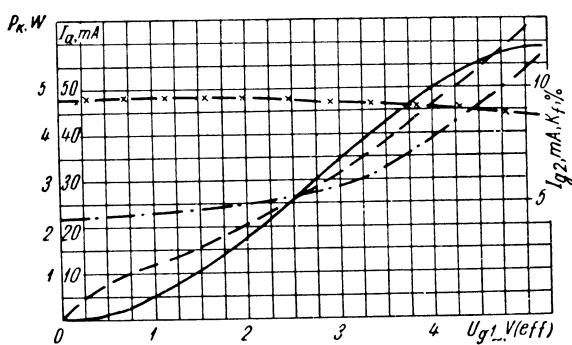


$$I_a, I_{g2}, P_k, k_f = f(R_a)$$

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| — — — P_k | $U_h = 6,3 \text{ V}$ |
| — — — k_f | $U_a = U_{g2} = 250 \text{ V}$ |
| -×-×- I_a | $U_{g1 \sim eff} = 4,2 \text{ V}$ |
| -·-·- I_{g2} | $R_k = 120 \Omega$ |



$$I_a, I_{g2}, P_k, k_f = f(U_{g1\sim \text{eff}})$$



$$I_a, I_{g2}, P_k, k_f = f(U_{g1\sim \text{eff}})$$